	Libelle		-	NbH CM	NbH TD	NbH TP	- 1	Max choix	ECTS	Code CNU	Session 1	Coeff	Durée	Session 2	Coeff	Durée		
129BC01	Nanophysique et Modélisation	BCC	_						11									
129UD01	Physique du solide et des surfaces		S9	10	10				2	28								
	Contrôle continu	_	_								CC1 C1	50%	2H	Ecrit E2	100%	2h		
	Contrôle continu	_									CC2 C2	50%	2H					
129UD09	Modélisation numérique des Nanomatériaux (ab-initio, DFT,)		S9	10		1	20		3	28								
	Contrôle continu		_			_					CC1 C1	33,33%	2H	Ecrit E2	33,33%	2h		
	Travaux Pratiques	_				_					TP P1	33,33%	2H	Repo	ort de note session 1	ion 1		
	Travaux Pratiques	_									TP P2	33,33%	2H					
129UD13	Nanophysique et nanomagnétisme	_	S9	20	20				4	28								
	Contrôle continu	_	_								CC1 C1	50%	2H	Ecrit E2	100%	2h		
	Contrôle continu	_									CC2 C2	50%	2H					
129UD15	Transport électronique et théorie moderne de la polarisation		S9	10	10				2	28								
	Contrôle continu	_									CC1 C1	50%	2H	Ecrit E2	100%	2h		
	Contrôle continu										CC2 C2	50%	2H		10070	211		
129BC02	Techniques innovantes en optique et diffraction	BCC	-						11									
129UD03	Techniques avancées de diffraction et diffusion		S9	10	10		8		3	28								
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	30%	2H	Ecrit E2	60%	2h		
	Contrôle continu	EPR									CC2 C2	30%	2H	ECITE EZ	0070			
	Travaux Pratiques										TP P2	40%	2H	Repo	rt de note sess	ion 1		
129UD10	Nanophotonique		S9	20					2	28								
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	66,67%	2H	Ecrit E2	66,67%	2h		
	Oral	EPR									Oral O1	33,33%	30min	Repo	rt de note sess	ion 1		
129UD16	Physique ultrarapide	UE	S9	10	5		5		2	28				Ecrit E2				
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	33,33%	2H		66,67%	2h		
	Contrôle continu	EPR									CC2 C2	33,33%	2H			211		
	Travaux Pratiques	EPR									TP P2	33,33%	2H	Repo	rt de note sess	ion 1		
519EN007	Capteurs et mesures holographiques	UE	S9	20			16		4	63								
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	66,67%	2H	Ecrit E2	66,67%	2h		
	Travaux pratiques	EPR									TP P1	33,33%	2H	Repo	rt de note sess	ion 1		
129BC03	Instrumentation et procédés de fabrication	BCC	S3						8									
129UD04	Microtechnologies - Microsystèmes	UE	S9	12			6		2	63								
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	60%	2H	Ecrit E2	60%	2h		
	Travaux pratiques	EPR									TP P1	40%	2H	Repo	t de note session 1			
139UD05	Microscopies	UE	S9	20	4				3	33								
	Electronique : Contrôle continu	EPR									CC1 C1	50%	2H	Ecrit E2	100%	2h		
	Champ proche : Contrôle continu										CC2 C2	50%	2H					
539EN006	Mesure et instrumentation avancée	_	S9	5	10	:	12		3	30								
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	60%	2H	Ecrit E2	60%	2h		
	Travaux pratiques	EPR									TP P1	40%	2H	Repo	eport de note session 1			

<u> </u>		ı	1				1	1			<u> </u>		T	1	<u> </u>	
				NbH	NbH	NbH	Min	Max		Code						
Id Apogée	Libelle	NEL	PEL	CM	TD	TP	choix	choix	ECTS	CNU	Session 1	Coeff	Durée	Session 2	Coeff	Durée
129BC05	Pratiques socio-professionnelles et stage	BCC	S3						27							
120UP01	Stage	UE	S0						23	0						
	Soutenance	EPR									Soutenance	100%		Pas de seconde session		sion
129UL01	Anglais	UE	S9		20				3	11NS						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	100%	2H	Ecrit E2	100,00%	2H
509EN009	Gestion de l'innovation	UE	S9	11,3	6,25				1	6						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	100%	2H	Pas de seconde session		sion
129BC04	UE optionnelle	CHO	S3						3							
129UD14	Plasmonique et applications	UE	S9	10	10				3	28						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	100%	2H	Ecrit E2	100,00%	2H
129UD17	Physique de la matière molle	UE	S9	10	10				3	28						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	50%	2H	Ecrit E2	100%	2h
	Contrôle continu	EPR									CC2 C2	50%	2H	ECHL EZ	100%	211
139UD06	Electronique plastique	UE	S9	24					3	33						
	Contrôle terminal	EPR									Ecrit E1	100%	2H	Ecrit E2	100,00%	2H
169UD25	Optoacoustique et applications	UE	S9	20					3	60						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	100%	2H	Ecrit E2	100,00%	2H

Condition validation du M2 :

Moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 Note minimum de 8/20 aux blocs.